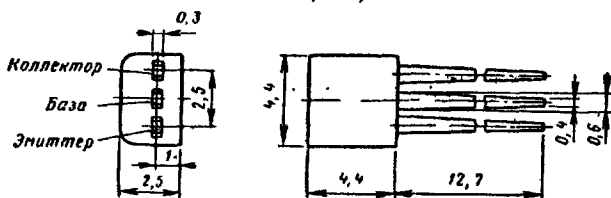


КТ357А, КТ357Б, КТ357В, КТ357Г

Транзисторы кремниевые эпитаксиально-планарные структуры *p-n-p* универсальные. Предназначены для применения в усилителях высокой частоты и переключающих устройствах. Выпускаются в пластмассовом корпусе с гибкими выводами. Тип прибора указывается в этикетке.

Масса транзистора не более 0,2 г

КТ357(А Г)



Электрические параметры

Статистический коэффициент передачи тока в схеме ОЭ при

$U_{КБ} = 0,5 \text{ В}$, $I_{К} = 10 \text{ мА}$:

$T = +25 \text{ }^\circ\text{C}$:

КТ357А, КТ357В 20 100

КТ357Б, КТ357Г 60 300

$T = +85 \text{ }^\circ\text{C}$:

КТ357А, КТ357В 20 250

КТ357Б, КТ357Г 60 750

$T = -40 \text{ }^\circ\text{C}$:

КТ357А, КТ357В 8 100

КТ357Б, КТ357Г 20 300

Различная частота коэффициента передачи тока при $U_{КБ} = 5 \text{ В}$, $I_{К} = 10 \text{ мА}$, не менее 300 МГц

Время рассасывания при $I_{К} = 10 \text{ мА}$, $I_{Б} = 1 \text{ мА}$ не более 150 нс

Напряжение насыщения коллектор — эмиттер при $I_{К} = 10 \text{ мА}$, $I_{Б} = 1 \text{ мА}$, не более 0,3 В

Напряжение насыщения база — эмиттер при $I_{К} = 10 \text{ мА}$, $I_{Б} = 1 \text{ мА}$, не более 1 В

Обратный ток коллектора при $U_{КБ} = U_{КБ \text{ макс}}$, не более 5 мкА

$T = +25 \text{ и } -40 \text{ }^\circ\text{C}$ 40 мкА

$T = +85 \text{ }^\circ\text{C}$ 5 мкА

Обратный ток эмиттера при $U_{ЭБ} = 3,5 \text{ В}$, не более 5 мкА

Емкость коллекторного перехода при $U_{БК} = 5 \text{ В}$, не более 7 пФ

Емкость эмиттерного перехода при $U_{ЭБ} = 0$, не более 10 пФ

Предельные эксплуатационные данные

Постоянные напряжения коллектор — база, коллектор — эмиттер

КТ357А, КТ357Б 6 В

КТ357В, КТ357Г 20 В

Постоянное напряжение эмиттер — база 3,5 В

Постоянный ток коллектора 40 мА

Импульсный ток коллектора при $t_u \leq 1 \text{ мкс}$ 80 мА

Постоянная рассеиваемая мощность коллектора t_c

$T \leq +50 \text{ }^\circ\text{C}$ 100 мВт

$T = +85 \text{ }^\circ\text{C}$ 50 мВт

Импульсная рассеиваемая мощность коллектора при $t_u \leq 1 \text{ мкс}$ 200 мВт

Тепловое сопротивление переход — среда 0,7 $^\circ\text{C}/\text{мВт}$

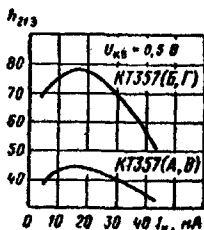
Температура *p-n* перехода $+120 \text{ }^\circ\text{C}$

Температура окружающей среды $-40 \text{ }^\circ\text{C}$ — $+85 \text{ }^\circ\text{C}$

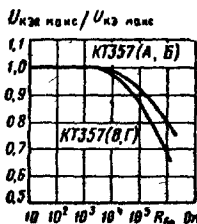
В диапазоне температур $+50 \text{ }^\circ\text{C}$ — $+85 \text{ }^\circ\text{C}$ допустимое значение рассеиваемой мощности снижается линейно

Допускается трехкратный изгиб выводов не ближе 3 мм от корпуса транзистора с радиусом закругления не менее 1 мм

Максимально допустимое расстояние от места пайки выводов до коллектора 5 мм при температуре не выше $+260 \text{ }^\circ\text{C}$ и длительности не более 10 с.



Зависимости статического коэффициента передачи тока от тока коллектора



Зависимость максимально допустимого постоянного напряжения коллектор — эмиттер от сопротивления база — эмиттер